

JP 55-3834

1/19/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0001909230

WPI ACC NO: 1980-14114C/198008

Gallium indium nitride light emitting device mfr. - where beryllium sulphide, zinc oxide, boron phosphide or gallium nitride layer is deposited on substrate

Patent Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME)

Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent

Application

Number

Kind

Date

Number

Kind

Date

Update

JP 1980003834

B

19800126

JP 197220053

A

19720226

198008

B

JP 49019782

A

19740221

198008 E

Alerting Abstract JP B

BeS, ZnO, BP or GaN layer is deposited on a quartz substrate, an SnO₂-coated quartz substrate, a BP(111)substrate, a BAs(111)substrate, a GaP(111)substrate, an alpha-SiC (0001) substrate, SnO (0001) substrate, or sapphire (0001) substrate. An active layer of Ga_{1-x}In_xN mixed crystal is formed on the deposited layer.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: GALLIUM; INDIUM; NITRIDE; LIGHT; EMIT; DEVICE; MANUFACTURE; BERYLLIUM; SULPHIDE; ZINC; OXIDE; BORON; PHOSPHIDE; LAYER; DEPOSIT; SUBSTRATE

Class Codes

(Additional/Secondary): H01L-021/20, H01L-033/00

File Segment: CPI; EPI

DWPI Class: E32; L03; U11; U12

Manual Codes (CPI/A-M): E31-H04; L03-D04B

Chemical Indexing

Chemical Fragment Codes (M3):

01 M902 A331 A349 A381 A940 C107 C520 C730 C801 C802 C803 C804 C806 C807
M411 M720 N000 Q334 Q451 Q454 R043

02 M903 A300 A331 A349 A381 A940 A990 C107 C520 C730 C801 C802 C803 C804
C806 C807 M411 M720 N000 Q334 Q451 Q454 R043

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication No. JP 49019782 A (Update 198008 E)

Publication Date: 19740221

Language: JA

Publication No. JP 1980003834 B (Update 198008 B)

Publication Date: 19800126

Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME)

Language: JA

Application: JP 197220053 A 19720226
Original IPC: H01L-21/20 H01L-33/00
Current IPC: H01L-21/20 H01L-33/00
?

⑫特許公報(B2) 昭55-3834

⑤Int.Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭⑭公告 昭和55年(1980)1月26日

H 01 L 33/00
21/2057377-5 F
7739-5 F

発明の数 2

(全5頁)

1

2

⑤Ga_{1-x}In_xN 発光素子の製法

②特 願 昭47-20053

②出 願 昭47(1972)2月26日

公 開 昭49-19782

④昭49(1974)2月21日

⑦発 明 者 新宮秀夫

京都市左京区松ヶ崎小脇町 28

⑦発 明 者 大槻徹

京都市左京区田中東春菜町23の1 10
祥風荘

⑦発 明 者 長村光造

京都市右京区嵯峨野秋街道町 16

⑦発 明 者 赤井慎一

大阪市此花区恩貴島南之町60住友 15
電気工業株式会社大阪製作所内

⑦出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5の15

⑦代 理 人 弁理士 上代哲司

⑥引用文献

米国特許 3560275 (USA) (クラス 148-171)

電子材料 昭46.12 第21~29頁

Applied Physics Letters 9[12] 1966.

12.15 第441~444頁

⑥特許請求の範囲

1 石英ガラス基板、SnO₂をコーティングした
石英ガラス基板、Bp111基板、BA s111
基板、GaP111基板、α-SiC0001基
板、ZnO0001基板およびサファイヤ0001 30
面上に成長させたBeS、ZnO、Bp、又は
Ga_{1-x}In_xNの成長層から成る基板、およびBeS若し
くはBeSeから成るグループから選ばれた一種
の基板上に、動作層としてGa_{1-x}In_xN混晶の
層を気相成長せしめることを特徴とするGa_{1-x} 35
In_xN発光素子の製法。

2 p型のBp若しくはBA s又は高抵抗のBeS

若しくはBeSeから成る基板上に動作層としてn
型Ga_{1-x}In_xN混晶の層を気相成長せしめるこ
とを特徴とするGa_{1-x}In_xN発光素子の製法。
但し、xは0と1の間の値である。

5 発明の詳細な説明

本発明はGa_{1-x}In_xNの混晶、すなわちGa_{1-x}
In_xN (0<x<1)を用いた可視光発光素子
に関するものである。

Ⅲ-V族化合物半導体を用いた発光素子として
はGaAs_{1-x}P_x (0<x<1)、Ga_{1-x}Al_x
As (0<x<1)、Ga_{1-x}In_xP (0<x<1)、
GaP、Ga_{1-x}Al_xP (0<x<1)、In_{1-x}
Al_xP (0<x<1)等を用いた発光素子がある
が、いずれも赤色、黄色、黄緑色の発光素子しか
得られていない。又深緑色から青色(又は紫色)
の発光素子としてはGa_{1-x}In_xNを用いた発光素子が提
案されている。しかしながらGa_{1-x}In_xNの禁制帯幅は
300°Kで3.39eVもあり、光でいえば紫外
光に相当する。従つてGa_{1-x}In_xNを用いて可視光を得
るには適当な不純物準位を介する電子の遷移を用
いることが不可欠となる。この場合、適当な不純
物が存在するかどうかは明らかでなかつた。

本発明はGa_{1-x}In_xN (0<x<1)の均一
な混晶が形成され得ることを明らかにするととも
に、Ga_{1-x}In_xNを用いた優れた可視光発光素
子の製法を提供するものである。

本発明の第1の発明は、電氣的にバイアスをか
けたときに可視光を発する発光素子の製法におい
て、適切な基板上に動作層としてGa_{1-x}In_xN
混晶の層を気相成長せしめることを特徴としてい
る。ここで、Ga_{1-x}In_xN混晶の層をpn接合
を含む層とすることが出来る。又n型Ga_{1-x}In_x
N混晶の層を含むMin構造をもつ層を動作層と
することが出来る。

但しMは金属、iは高抵抗Ga_{1-x}In_xN又は
絶縁物の層を意味する。

本発明において、適切な基板としては、石英ガ

3

ラス基板、 SnO_2 をコーティングした石英ガラス基板、BP 111基板、BA s 111基板、 α -SiC 0001基板、ZnO 0001基板、又はサファイヤ0001面上に成長させたBeS, ZnO, BP若しくはGaNの成長層から成る基板から選択

5 することができる。
更に、n型 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ とのヘテロ接合をpn接合として活用するために、適切な基板としてp型のBP若しくはBA sを用いたり、又、高抵抗のBeS若しくはBeSeを基板としてn型

以下本発明を実施例により説明する。

実施例 1:

本実施例は、GaN結晶とInN結晶とを昇華させて、石英ガラス基板上に $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層を成長させたものである。GaNとInNの割合を変化させることによつてxの値が変化させられた。成長した $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層はウルツ鉱型の結晶構造をもち、石英ガラス基板の面に垂直な方

20 向に、結晶の $\langle 0001 \rangle$ 方向が配向する傾向があつた。この成長のメカニズムはいわゆるレオタキシャル成長によるものと考えられる。

$\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層の厚さは5~10 μ であつた。

次にX線回折により結晶の格子定数を測定し、又光の吸収を測定することにより直接型の禁制帯幅を測定した。

第1図はその測定結果をまとめたものである。図は横軸に $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 中のInNのモル比xを、縦軸に禁制帯幅 E_g (eV)と格子定数a(\AA)およびc(\AA)とを示す。

X線回折の実験により、 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶の均一な層が成長していることが分つた。又光の吸収の実験から $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶が直接遷移型の

35 第1図から明らかなような $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶においては、格子定数がxとともに直線的に変化し、いわゆるヴェガートの法則が成立することが分る。一方禁制帯幅 E_g はxに対し凹型の曲線を呈し、CaNとInNの E_g を単純に直線で引いたのでは $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶の E_g の値を推定できないことを意味している。

次にZn, Cd, Mg, Be, Ge, Cuの様な不純物

4

をドーブすると禁制帯幅に相当するエネルギーの他に別の吸収帯が観測される。第1図の(X)印はZnをドーブした $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶に観測される附加的な光吸収のエネルギーを示す。例えば $\text{Ga}_{0.4}\text{In}_{0.6}\text{N}(\text{Zn})$ では2 eV以下のエネルギーの吸収が見られ、これは赤色発光用材料としても有用なことを示している。

もしZn, Cdなどの不純物をドーブしないときは、石英ガラス基板上に成長させた $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶はn型半導体であり、300°Kで1~1000 ohm·cmの比電気抵抗を示す。第2図は比較的高抵抗のn型 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ 混晶の層に電極を設けた実験を示すもので、図において、1は石英ガラス基板、2は $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層、3はInの蒸着膜、4はAuの微小電極である。電極4を正にバイアスしたとき、電極4の近傍で弱い発光が認められた。(図でh ν として発光を示す)。発光強度は弱いけれども例えば $\text{Ga}_{0.6}\text{In}_{0.4}\text{N}$ で青色の発光が観測されたことは興味深い。

実施例 2:

本実施例は SnO_2 の導電層をコーティングした石英ガラス基板上に $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層を成長させたものである。

第3図は本実施例により作成された発光ダイオードの構造を示し、1は石英板、5は導電層、2は $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層でn型半導体である。3と4は電極である。

6は活性窒素中でZnを拡散させたp型 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層であるn型 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層2の厚さは5~10 μ 、p型 $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層6の厚さは1~2 μ であり、p層6の比電気抵抗は $10^3 \sim 10^6$ ohm-cmであつた。電極4をプラスにしてバイアスを加えた所、層6から肉眼ではつきり認められる発光が観測された。

発光色はxの大きい所($x \cong 0.6$)で赤から黄色xの小さい所($x \leq 0.3$)で黄緑から深緑色にわたつていた。

実施例 3:

本実施例では単結晶基板が用いられた。BP, BA sの111面、GaPの111面、 α -SiCの0001面、ZnOの0001面等が用いられた。又サファイヤ(Al_2O_3)上にエピタキシャル成長させたBeS, ZnO, BP, GaN等を基板として、更にその上に $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}$ の層を成長さ

5

せることも可能である。

第4図はこの様な $Ga_{1-x}In_xN$ の層の一例であり、7はサファイヤの0001面をもつ基板、8はn型のZnOのエピタキシャル層、そして2はn型の $Ga_{1-x}In_xN$ のエピタキシャル層である。

このウェハに更に高抵抗の $Ga_{1-x}In_xN$ 又はp型の $Ga_{1-x}In_xN$ を成長させれば、容易にいろいろな発光素子用材料が得られる。その構造の1例を第5図に示す。第3図、第4図と同一符号は同じものを示す。第5図で電極3, 4の間にバイアスをかければ、高抵抗又はp型の $Ga_{1-x}In_xN$ の層6の部分で発光が観測される。この場合、層2の中のxの値よりも層6の中のxの値を小さくすることによつて、外部へ光を取り出し易くすることも可能である。

以上の実施例では、発光に寄与する動作層が $Ga_{1-x}In_xN$ 混晶の層そのものである場合にについて説明したが、他の半導体とのヘテロ接合を含む層を動作層とする発光素子を作ることにもできる。例えばp型のBPやBA_s又は高抵抗のBeSeと、n型の $Ga_{1-x}In_xN$ とのヘテロ接合を用いれば格子定数の不適合の少い発光素子が得られる。この様な構造の発光素子は特に深緑から青色(又は紫色)にまたがる可視光の発光素子として有用である。更に複数個の発光素子を用いることによ

6

り、数字や文字等の表示装置を形成することが出来る。

又 $Ga_{1-x}In_xN$ 混晶を用いた発光素子の効率が向上すれば、緑色から青色(又は紫色)までのレーザー作用を有する高効率発光素子も可能となるであろう。

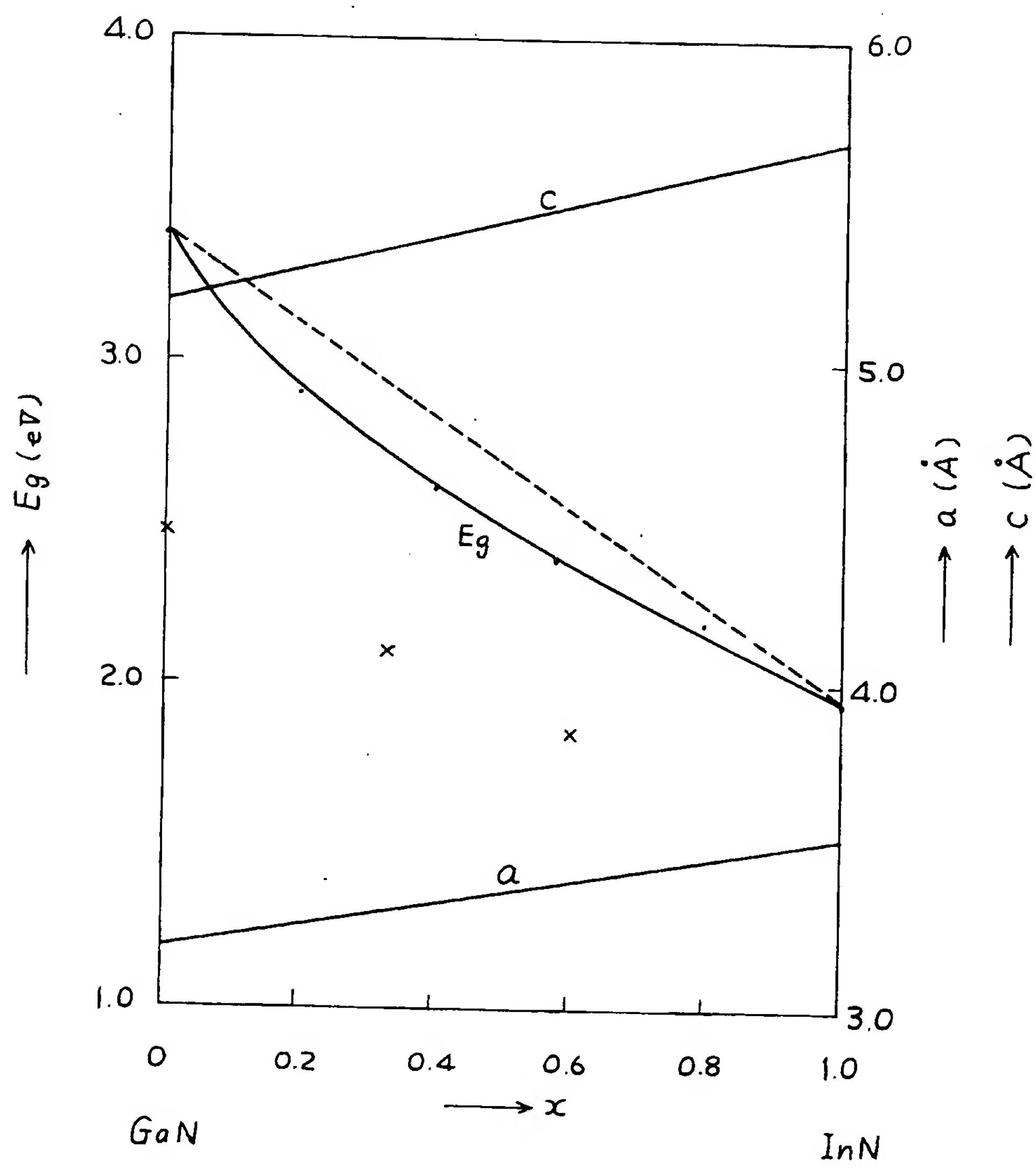
以上述べた如く、本発明は、電氣的にバイアスをかけたときに可視光を発する発光素子の製法において、適切な基板上に動作層として $Ga_{1-x}In_xN$ 混晶の層を気相成長せしめることを可能にするもので、従来のGaP, $GaAs_{1-x}P_x$, $In_{1-x}Al_xP$ などの半導体では得られなかつた深緑色から青色の発光素子の製作を可能にし、深緑色から青色までの各種表示素子を含む新しい光半導体素子の分野の発展に寄与するものである。

図面の簡単な説明

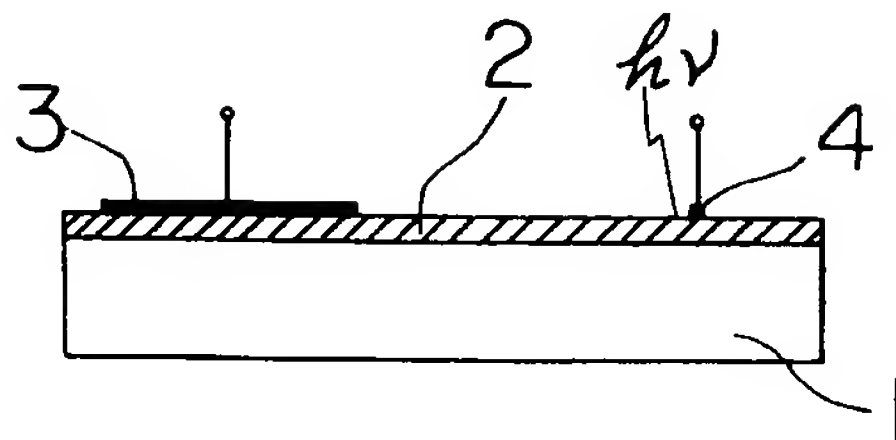
第1図は $Ga_{1-x}In_xN$ ($0 < x < 1$) 混晶の禁制帯幅と、格子定数の変化を示す図で、第2図、第3図および第5図は本発明の実施例を示す断面図で、第4図は第5図に示す発光素子に用いられた $Ga_{1-x}In_xN$ の層を示す図である。

図において、1は石英基板、2はn型 $Ga_{1-x}In_xN$ の層、3は陰極、4は陽極、5は透明な導電層、6は高抵抗又はp型の $Ga_{1-x}In_xN$ の層、7はサファイヤ単結晶基板、8はZnOのエピタキシャル層である。

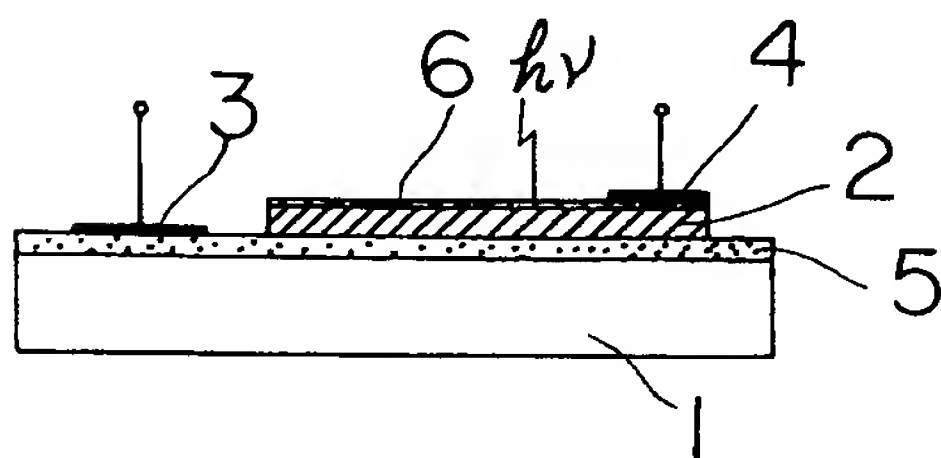
第 1 図



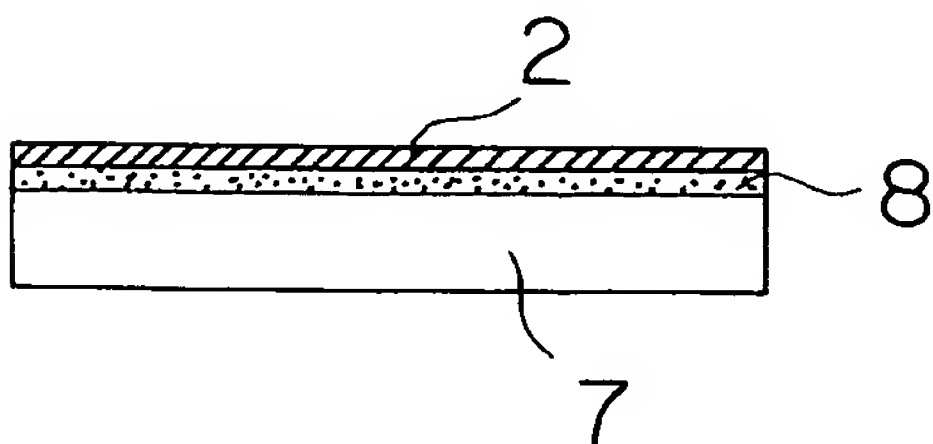
第 2 図



第 3 図



第 4 図



第 5 図

